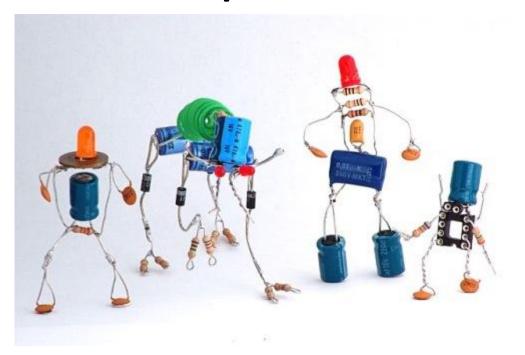
Circuitos Electrónicos II (66.10) Diseño de Circuitos Electrónicos (86.10)

Departamento de Electrónica – FIUBA

Introducción a la Tecnología de Componentes



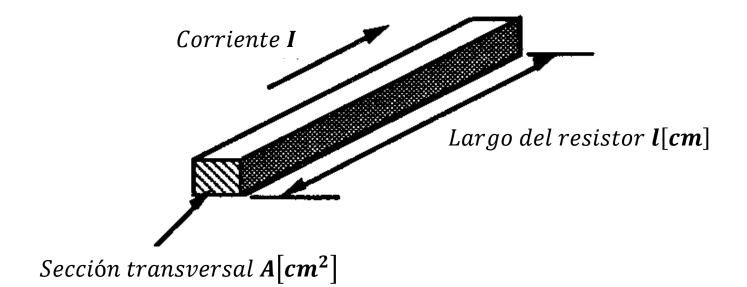
Componentes Electrónicos

Un componente electrónico es una entidad física en un sistema electrónico cuya intención es afectar los electrones (o sus campos asociados) en una forma consistente con la función esperada del sistema electrónico.

Componentes Pasivos

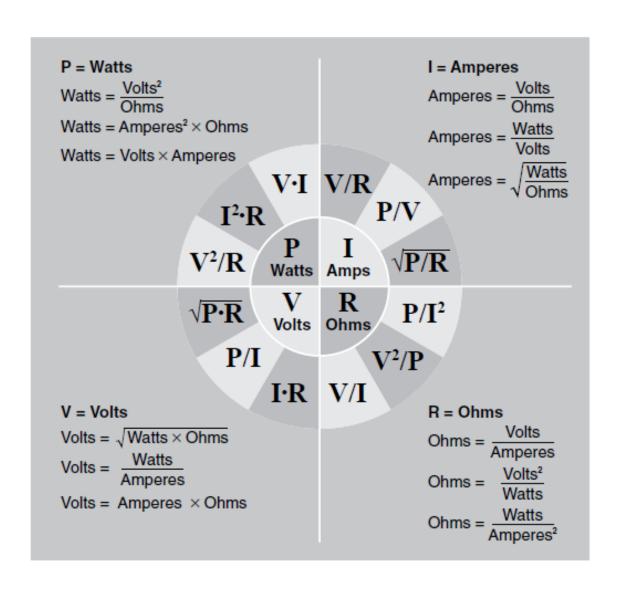
- Resistores
- Capacitores
- Inductores
- Transformadores

Resistores: Características



$$R[\Omega] = \frac{\rho . l}{A}$$
, $\rho [\Omega. cm]$: Resistividad

Resistores: Características ideales



Resistores: Aplicaciones

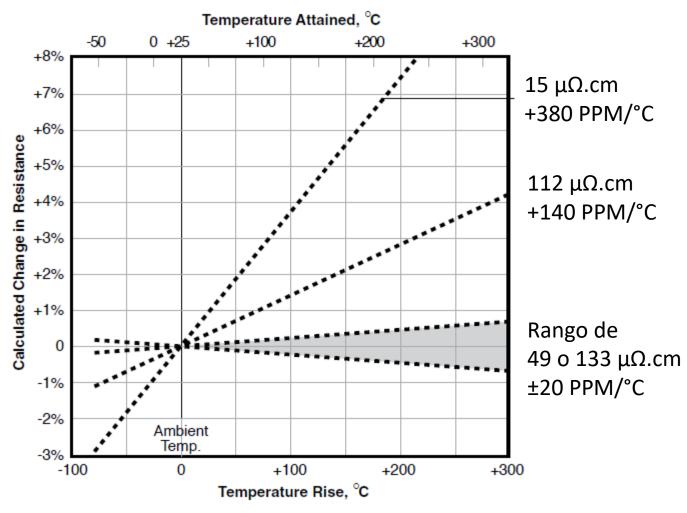
- Polarización
- Control de ganancia
- Fijación de constantes de tiempo
- Divisores de tensión
- Adaptación de impedancias
- Generación de calor
- Sensado

Resistores: ¿Qué especificar?

- Valor nominal: Especificado a 20°C.
- Tolerancia: Cuánto se puede desviar la resistencia del valor nominal. (5%, 1%, 0.5%)
- Coeficiente de temperatura (TCR): Dado en %/°C o ppm/°C
- Rango de temperatura: Comercial (0°C a 70°C), Militar (-55°C a 125°C).
- **Estabilidad**: Máximo cambio permitido debido a influencias térmicas, eléctricas o mecánicas.
- **Disipación de potencia**: Máxima potencia para una temperatura ambiente definida.
- **Tensión de operación**: Máxima tensión continua o eficaz que soporta de modo continuo.
- Alinealidades: Se mide la tercer armónica para una senoidal de 10 kHz.
- Ruido: Ruido térmico y corriente de ruido.
- Estabilidad pulsante (Pulse stability): Puede soportar mayor potencia que la máxima especificada en este modo de operación.
- Resistencia térmica: $\Delta \theta = P . R_{th}$
- Características de alta frecuencia

Resistores: Coeficiente de temperatura

(según aleación)



Coeficiente de temperatura: R(T2) = R(T1). $[1 + \alpha_{T1}(T2 - T1)]$

T1: Temperatura de referencia. Típicamente 20°.

Resistores: Estabilidad

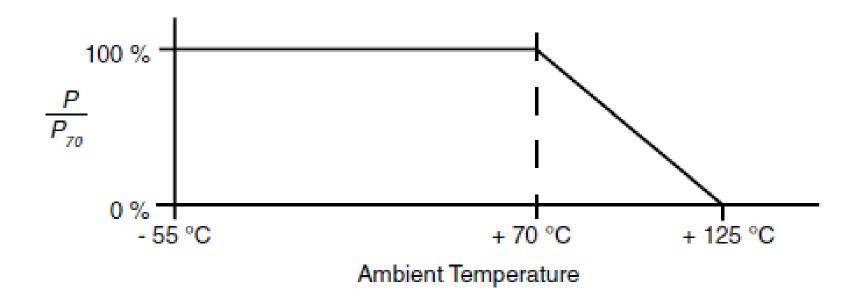
Las pruebas de estabilidad están definidas en estándares.

Clases de Estabilidad	Pruebas de largo plazo	Pruebas de corto plazo
2	± (2%.R+0.1Ω)	± (0.5%.R+0.05Ω)
1	± (1%.R+0.05Ω)	± (0.25%.R+0.05Ω)
0.50	± (0.5%.R+0.05Ω)	± (0.10%.R+0.01Ω)
0.25	± (0.25%.R+0.05Ω)	± (0.05%.R+0.01Ω)
0.10	± (0.10%.R+0.02Ω)	± (0.05%.R+0.01Ω)
0.05	± (0.05%.R+0.01Ω)	± (0.025%.R+0.01Ω)

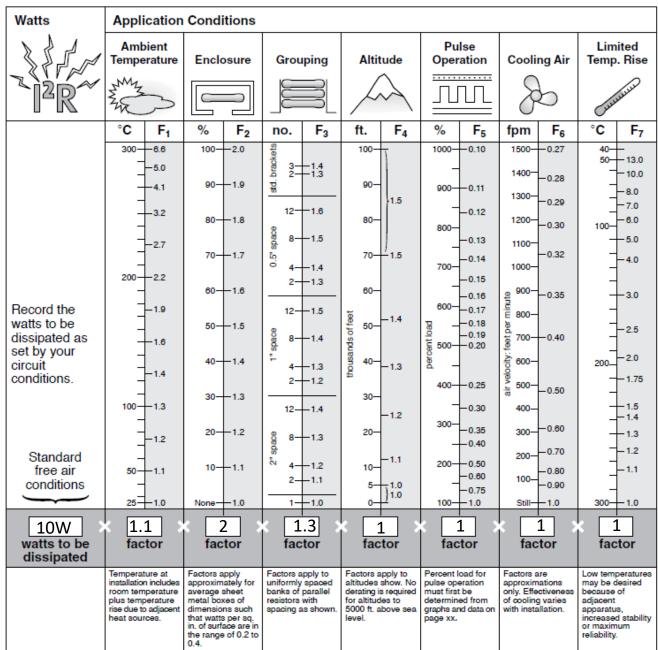
- Secuencias climáticas
 - Exposición a calor húmedo
- Exposición a altas temperaturas con cambios cíclicos en la carga.

- Sobrecarga
- Robustez mecánica de terminales
 - Calor de soldadura
- Cambios bruscos de temperatura
 - Vibraciones

Resistores: Disipación de potencia



Resistores: Disipación de potencia

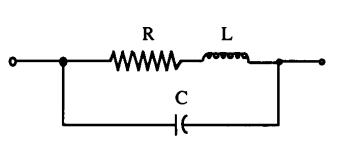


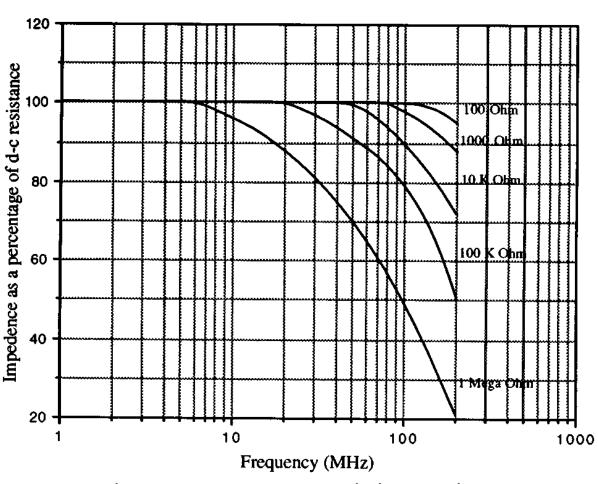
Supongamos que tenemos 4 resistores disipando 10W cada uno, que se montarán juntos, separados por una pulgada. Temperatura ambiente de 50°C. Totalmente encerrados.

P_R=28.6W

Nota de aplicación de OHMITE

Resistores: Característica de alta frecuencia





Impedancia como porcentaje de la impedancia en continua en función de la frecuencia, para resistores metal-film.

Resistores (Fijos): Tipos de fabricación

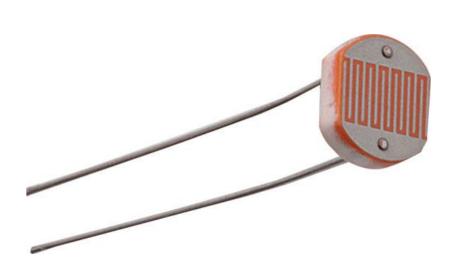
Resistores	Película de carbón	Película metálica	Película gruesa	Papel de aluminio	Composición de carbón	Alambre arrollado
Valor de resistencia	10Ω a 22MΩ	0.22Ω a 22ΜΩ	1Ω a $100MΩ$	2mΩ a $1MΩ$	1Ω a 20ΜΩ	0.1Ω a 300kΩ
Tolerancia [%]	±2 a ±10	±0.1 a ±2	±1 a ±5	±0.005 a ±5	±5 a ±20	±0.1 a ±10
Coeficiente de temperatura [ppm/°C]	-200 a -1500	±5 a ±50	±50 a ±200	±2 a ±50	-200 a -1500	±1 a ±200
Temp. De operación max [°C]	155	155	155	150	150	400
Disipación nominal P ₇₀ [W]	0.25 a 2	0.063 a 1	0.063 a 0.25	0.25 a 10	0.25 a 1	0.25 a 100
Estabilidad a P ₇₀ (1000h) ΔR/R[%]	±0.8 a ±3	±0.15 a ±0.5	±1 a ±3	±0.05	+4/-6 (tipico -3)	±1 a ±10
Tensión máxima [V]	200 a 1000	50 a 500	50 a 200	200 a 500	150 a 350	$\sqrt{P_{70}.R}$
Corriente de ruido [µV/V]	<1	<0.1	<10	<0.025	2 a 6	Despreciable
Alinealidad A ₃ [dB]	>100	>110	>50	Despreciable	~60	Despreciable

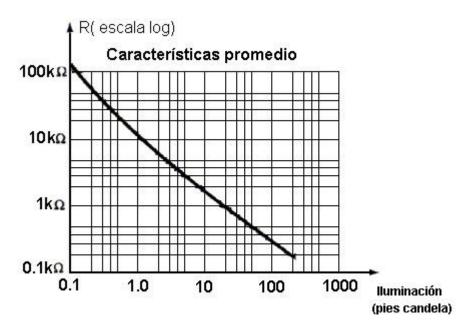
PRECISION METAL FILM FIXED RESISTOR

General Specifications

Part No.	Style	Max. Overload	Max. Working	Dielectric With -	Resistance	T.C.R.	Resistance	S	pecial Orde	er
	og.c	Voltage	Voltage	standing V.	Tolerance		Range	Resistance Tolerance	T. C. R.	Resistance Range
MF0W8 MF0S4	MF-12 MF-25-S	400V	200V	400V	± 5%	±200PPM°C	1Ω - 1ΜΩ	±0.25%	±15PPM°C	51.1Ω-2004Ω
WI 004	-25-5				± 2% ± 1%	±100PPM°C ±50PPM°C	10Ω - 1ΜΩ	±0.5%	±25PPM°C ±50PPM°C	51.1Ω-511ΚΩ
MFF04	MF-40-SS	400V	200V	200V	1170	150 7111 0	10Ω - 1ΜΩ		150PPM°C	
MF0W4 MF006	MF-25 MF-60-S	500V	250V	500V	± 5%	±200PPM°C	1Ω - 1ΜΩ	±0.1%	±15PPM°C	100Ω-100ΚΩ
MF006	MF-60-S	± 2% ±100PPI	±100PPM°C			±25PPM°C	511Ω-330ΚΩ			
MFFU2	MF-50-SS	500V	250V	250V	± 1%	±50PPM/°C	10Ω - 1ΜΩ	±0.5%	±50PPM°C	10Ω–1ΜΩ
					± 5%	±200PPM°C	1Ω - 1ΜΩ	±0.1%	±15PPM°C	100Ω-330ΚΩ
MF0W2 MF0S2	MF-50 MF-50-S	700V	350V	700V	± 2%	±100PPM°C	10Ω - 1ΜΩ	±0.25%	±25PPM°C	51.1Ω-51 1 ΚΩ
					± 1%	±50PPM/°C	10Ω - 1ΜΩ	±0.5%	±50PPM°C	10Ω–1ΜΩ
					± 5%	±200PPM°C	10Ω - 1ΜΩ	±0.1%	±15PPM°C	100Ω-330ΚΩ
MF01W MF02W MF03W	MF-100 MF-200 MF-300	1000V	500V	1000V	± 2%	±100PPM°C	51.1Ω-1ΜΩ	±0.25%	±25PPM°C	51.1Ω-511ΚΩ
					± 1%	±50PPM/°C	51.1Ω-1ΜΩ	±0.5%	±50PPM°C	51.1Ω–1ΜΩ

Foto-resistor (LDR)





• Foto-resistor (LDR): Aplicación.

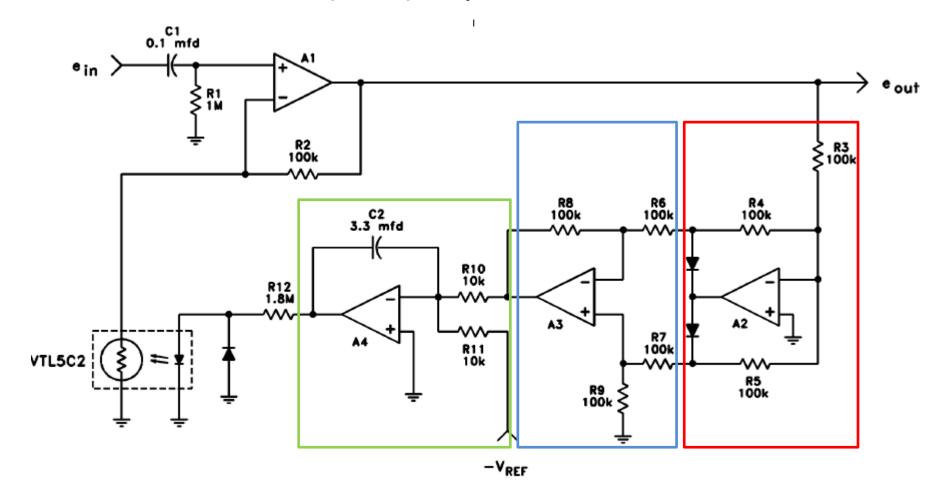
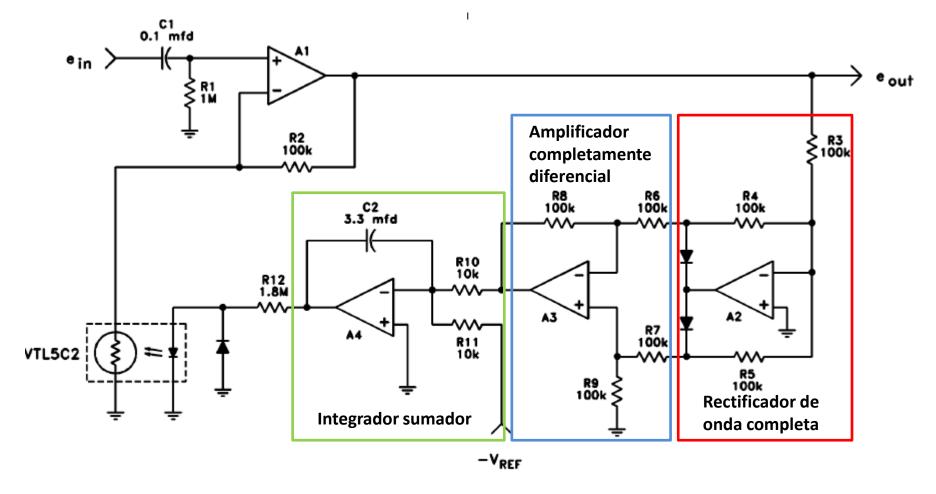


Foto-resistor (LDR): Aplicación.



Control automático de ganancia (AGC)

Termistores: NTC y PTC

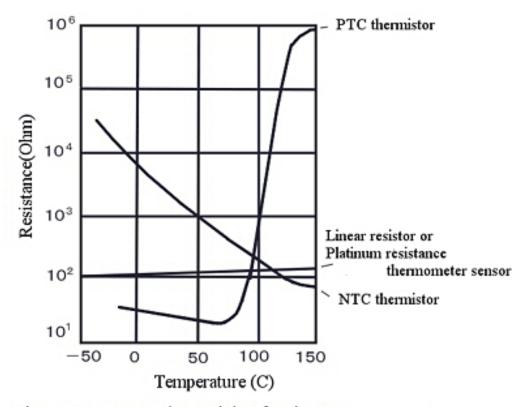
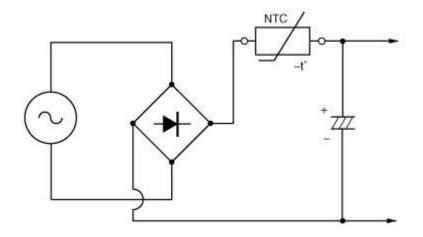
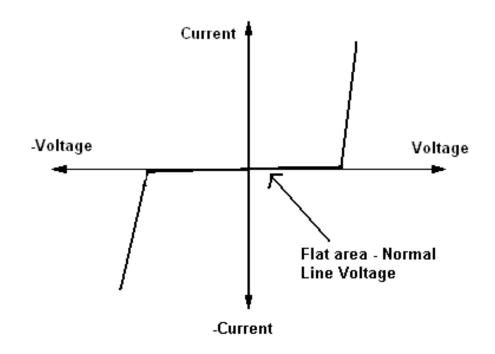


Figure 1 Temperature Characteristics of Resistance Temperature Sensor

Termistores NTC: Aplicación.

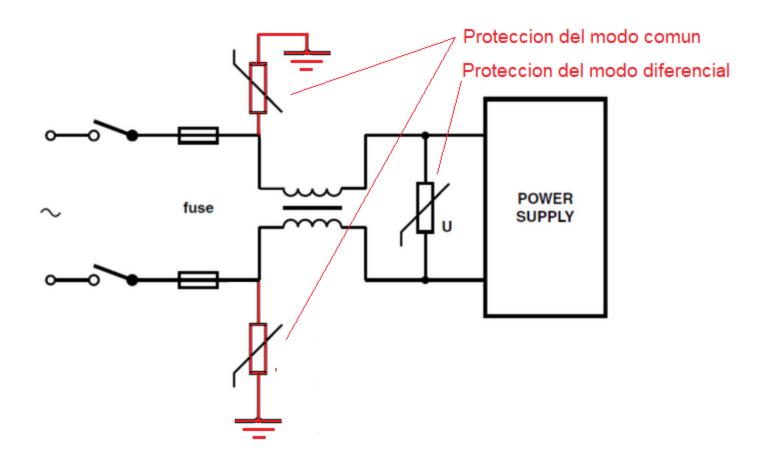


Varistor



Varistor Volt-Ampere Characteristics Curve

Varistor: Aplicación

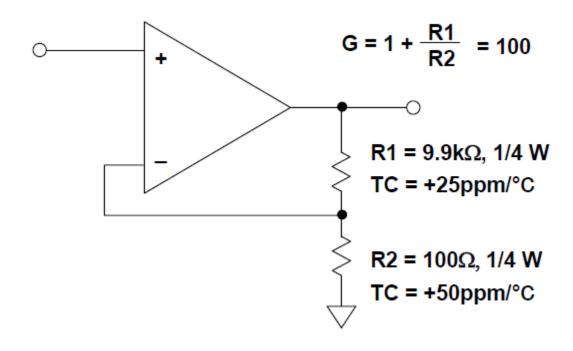


Varistores

				Ratings	& Specifi	ications								
					Maximum Rating (85°C)			Specifications (25°C)						
TMOV® Varistor iTMOV® Var			Cont		Continuous		Transient		Vari	istor	Maximum		Typical	
Lead-free And Compliant M		Lead-free and Compliant Mo		Disc Diameter	AC Volts	DC Volts	Energy 2ms		Surge t 8/20µs	1mA Test		Volt 8/2	age	Capaci- tance f = 1MHz
Part Number	Branding	Part Number	Branding	(mm)	V _{MIACIRMS}	V _{M(DC)} (V)	W _m	I _m 1 x Pulse	I _m 2 x Pulse	V _{NDC)} Min	V _{N(DC)} Max V)	V _c (V)	I _{PK}	C (pF)
TMOV/14DD11EE	DATISE	TMOV/14DD11EM	DATISENA	(mm)				(A)	(A)				(A)	-
TMOV14RP115E TMOV20RP115E	P4T115E P2T115E	TMOV14RP115M TMOV20RP115M	P4T115M P2T115M	14 20	115 115	150 150	35 52	6000 10000	4500 6500	162 162	198 198	300	50 100	1100 2400
TMOV14RP130E	P4T130E	TMOV14RP130M	P4T130M	14	130	170	50	6000	4500	184.5	225.5	340	50	1000
TMOV20RP130E	P2T130E	TMOV20RP130M	P2T130M	20 14	130 140	170 180	100	10000	6500	184.5	225.5	340	100	1900
TMOV14RP140E	P4T140E	TMOV14RP140M	P4T140M				55	6000	4500	198	242	360	50	900
TMOV20RP140E	P2T140E	TMOV20RP140M	P2T140M	20	140	180	110	10000	6500	198	242	360	100	1750
TMOV14RP150E	P4T150E	TMOV14RP150M	P4T150M	14	150	200	60	6000	4500	216	264	395	50	800
TMOV20RP150E	P2T150E	TMOV20RP150M	P2T150M	20	150	200	120	10000	6500	216	264	395	100	1600
TMOV14RP175E	P4T175E	TMOV14RP175M	P4T175M	14	175	225	70	6000	4500	243	297	455	50	700
TMOV20RP175E	P2T175E	TMOV20RP175M	P2T175M	20	175	225	135	10000	6500	243	297	455	100	1400
TMOV14RP200E	P4T200E	TMOV14RP200M	P4T200M	14	200	260	75	6000	4500	283	345	530	50	630
TMOV20RP200E	P2T200E	TMOV20RP200M	P2T200M	20	200	260	154	10000	6500	283	345	530	100	1250
TMOV14RP230E	P4T230E	TMOV14RP230M	P4T230M	14	230	300	80	6000	4500	324	396	595	50	550
TMOV20RP230E	P2T230E	TMOV20RP230M	P2T230M	20	230	300	160	10000	6500	324	396	595	100	1100
TMOV14RP250E	P4T250E	TMOV14RP250M	P4T250M	14	250	320	100	6000	4500	351	429	650	50	500
TMOV20RP250E	P2T250E	TMOV20RP250M	P2T250M	20	250	320	170	10000	6500	351	429	650	100	1000
TMOV14RP275E	P4T275E	TMOV14RP275M	P4T275M	14	275	350	110	6000	4500	387	473	710	50	450
TMOV20RP275E	P2T275E	TMOV20RP275M	P2T275M	20	275	350	190	10000	6500	387	473	710	100	900
TMOV14RP300E	P4T300E	TMOV14RP300M	P4T300M	14	300	385	125	6000	4500	423	517	775	50	400
TMOV20RP300E	P2T300E	TMOV20RP300M	P2T300M	20	300	385	250	10000	6500	423	517	775	100	800
TMOV14RP320E	P4T320E	TMOV14RP320M	P4T320M	14	320	420	136	6000	4500	459	561	840	50	380
TMOV20RP320E	P2T320E	TMOV20RP320M	P2T320M	20	320	420	270	10000	6500	459	561	840	100	750
TMOV14RP385E	P4T385E	TMOV14RP385M	P4T385M	14	385	505	150	6000	4500	558	682	1025	50	360
TMOV20RP385E	P2T385E	TMOV20RP385M	P2T385M	20	385	505	300	10000	6500	558	682	1025	100	700
TMOV14RP420E	P4T420E	TMOV14RP420M	P4T420M	14	420	560	160	6000	4500	612	748	1120	50	300
TMOV20RP420E	P2T420E	TMOV20RP420M	P2T420M	20	420	560	320	10000	6500	612	748	1120	100	600
TMOV14RP460E	P4T460E	TMOV14RP460M	P4T460M	14	460	610	180	6000	4500	675	825	1240	50	220
TMOV20RP460E	P2T460E	TMOV20RP460M	P2T460M	20	460	610	360	10000	6500	675	825	1240	100	200
TMOV14RP510E	P4T510E	TMOV14RP510M	P4T510M	14	510	670	185	6000	4500	738	902	1355	50	200
TMOV20RP510E	P2T510E	TMOV20RP510M	P2T510M	20	510	670	325	10000	6500	738	902	1355	100	350
TMOV14RP550E	P4T550E	TMOV14RP550M	P4T550M	14	550	715	190	6000	4500	819	1001	1500	50	180
TMOV/20 DDEEDE	DOTECOE	TA 401/20DDEE014	DOTECONA	20	EEO	715	000	10000	CEOO	010	1001	1500	100	200

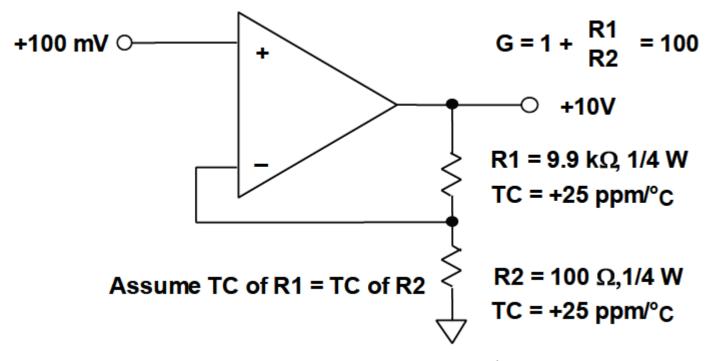
TMOV20RP550E | P2T550E | TMOV20RP550M | P2T550M

Resistores: Ejemplo 1



- Un cambio en la temperatura de 10°C produce un cambio en la ganancia de 250ppm
- Representa un error de 1 bit menos significativo en un sistema digital de 12 bits. En un sistema de 16 bits, es un desastre!!!

Resistores: Ejemplo 2

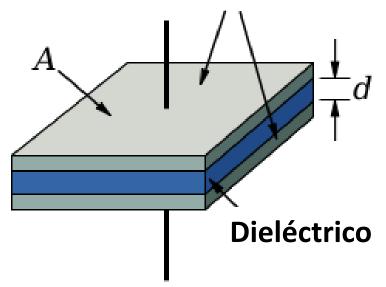


- Suponiendo una resistencia térmica de R1 y R2 de 125°C/W
- La temperatura de R1 aumenta 1.25° ya que PD=9.9 mW
- La temperatura de R2 practicamente se mantiene constante, PD=0.1 mW
- La ganancia cambia en 31 ppm, que representa un error de 1/2 bit menos significativo
 @14 bits

En circuitos de precisión se requiere que los resistores estén apareados. Una solución es utilizar resistores integrados en el mismo sustrato.

Capacitores: Características

Placas conductoras



$$\mathsf{C}[F] = \frac{\varepsilon_0.\varepsilon_r.\lfloor (N-1)A\rfloor}{d}$$

 ε_0 : Cte. dielectrica del vacio 8.85. $10^{-12} \frac{F}{m}$

 $\boldsymbol{\varepsilon_r}$: Cte. dieléctrica relativa

N: Número de placas

 $A[m^2]$: Área de las placas

d[m]: Separación entre placas

Capacitores: Características

$$W = \frac{C.V^2}{2}$$

W[**J**]: Energia almacenada

C[F]: Capacidad

V[V]: Voltaje aplicado

La constante dieléctrica determina la cantidad de energía electróstica por unidad de volumen que se puede almacenar para un voltaje aplicado.

TABLE 1.4 Comparison of Capacitor Dielectric Constants

	K
Dielectric	(Dielectric Constant)
Air or vacuum	1.0
Paper	2.0-6.0
Plastic	2.1-6.0
Mineral oil	2.2-2.3
Silicone oil	2.7-2.8
Quartz	3.8-4.4
Glass	4.8-8.0
Porcelain	5.1-5.9
Mica	5.4-8.7
Aluminum oxide	8.4
Tantalum pentoxide	26
Ceramic	12-400,000

Capacitores: Aplicaciones

- Filtrado
- Desacople/Bypass
- Acople/Bloqueo de continua
- Snubbers
- Almacenamiento de energía
- Circuitos resonantes
- Corrección de Factor de Potencia
- Osciladores
- Compensación

Capacitores: ¿Qué especificar?

- Valor nominal: Especificado a 20°C.
- **Tensión de operación**: Máxima tensión continua o eficaz que soporta de modo continuo.
- Tolerancia: Cuánto se puede desviar la capacitancia del valor nominal. (±1%=F, ±2%=G, ±2.5%=H, ±5%=J, ±10%=K, ±20%=M)
- **Corriente de fuga**: Del orden de los pA a µA según el dieléctrico. Se puede especificar la resistencia de aislación en lugar de la corriente de fuga.
- Rango de temperatura: Comercial (0°C a 70°C), Militar (-55°C a 125°C).
- Coeficiente de temperatura (TCR): Dado en %/°C o ppm/°C (Ej. P100, N50)
- Polaridad: Para los capacitores electrolíticos se indica la polaridad de los terminales.
- Resistencia equivalente serie (ESR): Dada en Ω o m Ω .
- Inductancia equivalente serie (LSR): Dada en pHy o nHy.
- Factor de calidad: Relación de la reactancia y la resistencia a una dada frecuencia.
- Factor de disipación: Es el inverso del factor de calidad. Cuánto más bajo mejor.
- Características de alta frecuencia

Código EIA RS-198 Clase I para capacitores

Coeficiente de temperatura ppm/°C	Multiplicador del coeficiente de temperatura	Tolerancia del coeficiente de temperatura ppm/°C
C: 0.0	0: -1	G: +/-30
B: 0.3	1: -10	H: +/-60
L: 0.8	2: -100	J: +/-120
A: 0.9	3: -1000	K: +/-250
M: 1.0	4: +1	L: +/-500
P: 1.5	6: +10	M: +/-1000
R: 2.2	7: +100	N: +/-2500
S: 3.3	8: +1000	
T: 4.7		
V: 5.6		
U: 7.5		

Por ejemplo un capacitor con código **P3K** tendrá una variación en temperatura de -1500 ppm/°C con una tolerancia máxima de +/-250 ppm/°C.

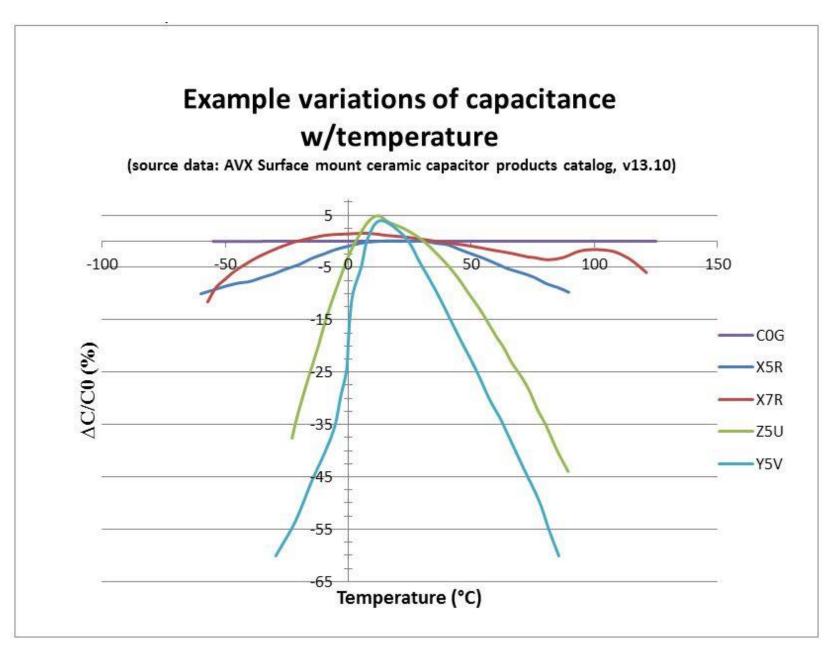
Código EIA RS-198 Clase II para capacitores

Código para temperatura mínima	Código para temperatura máxima	Código para el coeficiente de temperatura
X = -55°C	4 = +65°C	P = ±10%
Y = -30°C	5 = +85°C	R = ±15%
Z = +10°C	6 = +105°C	S = ±22%
	7 = +125°C	T = +22% / -33%
	8 = +150°C	U = +22% / -56%
	9 = +200°C	V = +22% / -82%

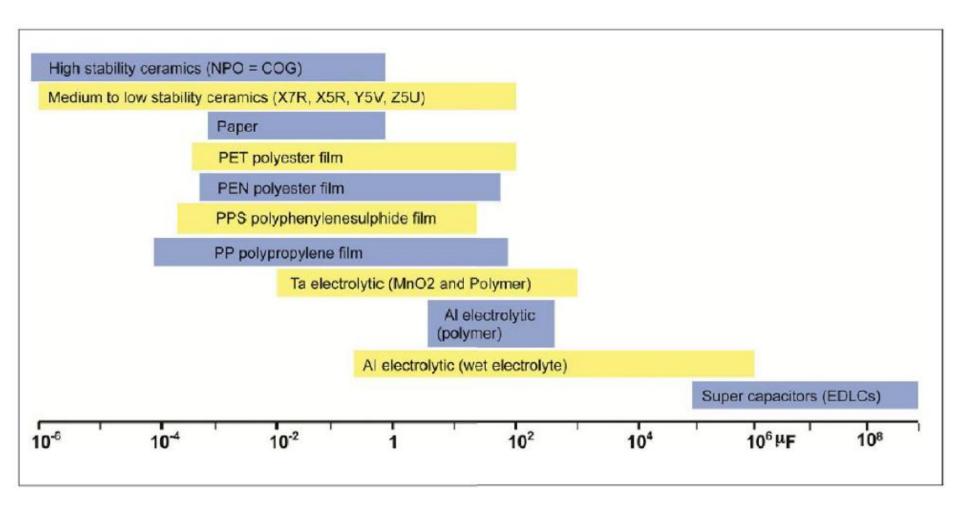
Por ejemplo un capacitor con código **Z5U** va a operar de +10°C a +85°C con una variación máxima de +22% a -56%.

Un capacitor con código **X7R** va a operar de -55°C a +125°C con una variación máxima de +/- 15%.

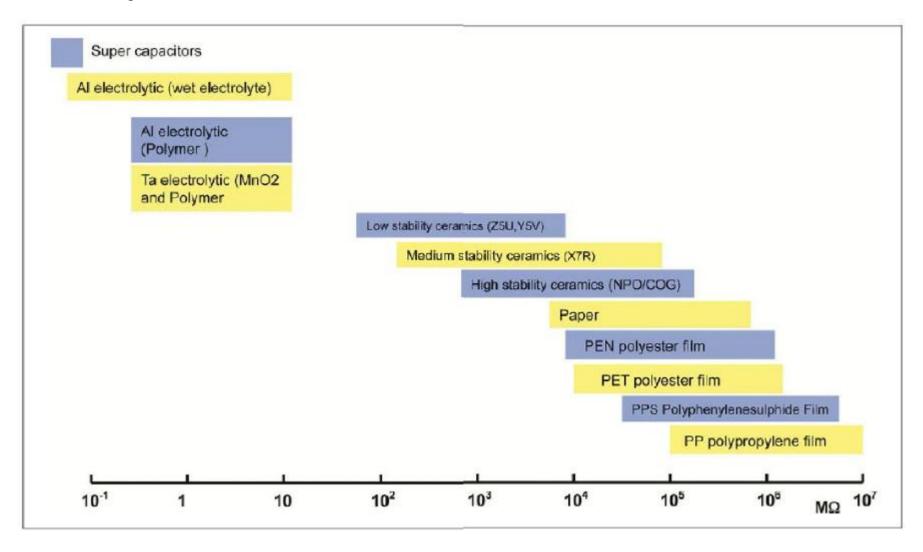
Capacitores: Coeficiente térmico (ejemplo)



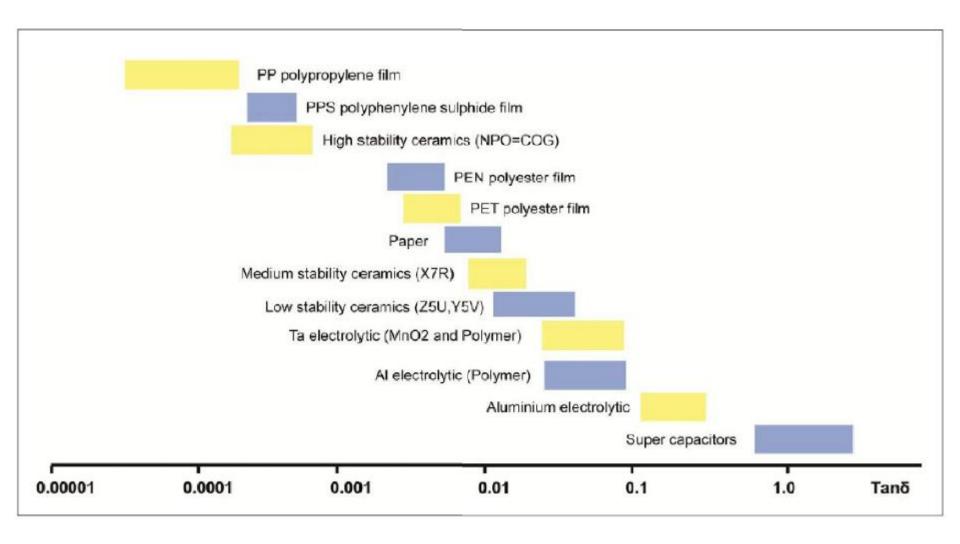
Capacitores: Valores según tipo



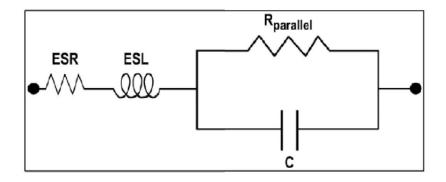
Capacitores: Resistencia de aislación

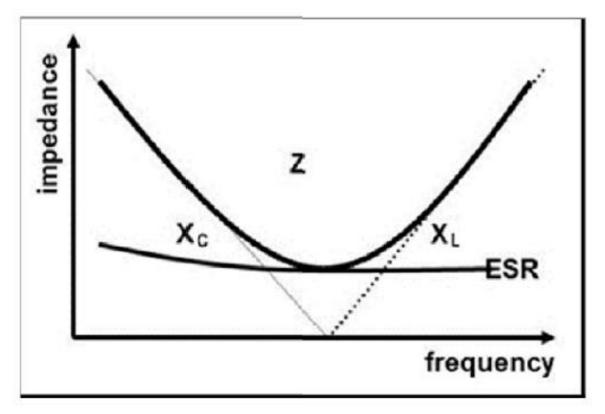


Capacitores: Factor de disipación



Capacitores: Característica de alta frecuencia



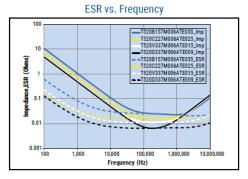


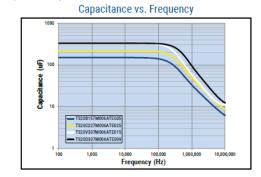
Capacitores: Tipos de fabricación

Tipo	Rango	ESR	Fugas	Voltaje	Temperatura	Notas generales	
Cerámico	рҒ а μҒ	Baja	Medias	Alto	-55°C a 125°C	Baratos, de propósito general.	
PET film	рF а µF	Baja	Medias	Bajo	-55°C a 125°C	Proposito general, bajo DC BIAS, baja frecuencia.	
PEN film	рF а µF	Baja	Medias	Bajo	-55°C a 150°C	Proposito general. Mayor resistencia a la temperatura que los PET.	
PP film	рҒ а µҒ	Baja	Bajas	Alto	-55°C a 125°C	Para alta frecuencia y pulsos. Supresión de interferencias.	
Mica y Vidrio	pF a nF	Baja 0.01Ω a 0.1Ω	Bajas	Alto	-55°C a 125°C	Para filtros RF, caros, muy estables.	
Papel y Plástico	Alguno s μF's	Media	Medias	Alto	Variable	Para baja frecuencia, baratos.	
Tantalio	μF's	Alta 0.5Ω a 5Ω	Bajas	Bajo	-55°C a 125°C	Caros, alinéales (malos para audio).	
OSCON	μF's	Baja 0.01Ω a 0.5Ω	Bajas	Bajo	-55°C a 105°C	Mejor calidad, mas caros.	
Electrolítico de aluminio	Varios μF's	Alta 0.05Ω a 2Ω	Medias	Bajo	-40°C a 105°C	Para bajas a medias frecuencias, baratos, almacenamiento de energía.	

Capacitores: Tipos de fabricación

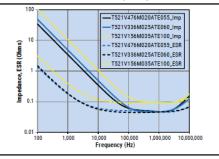




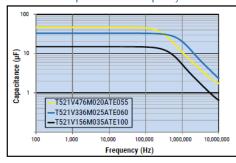


T521 High Voltage (12 V - 75 V)

ESR vs. Frequency



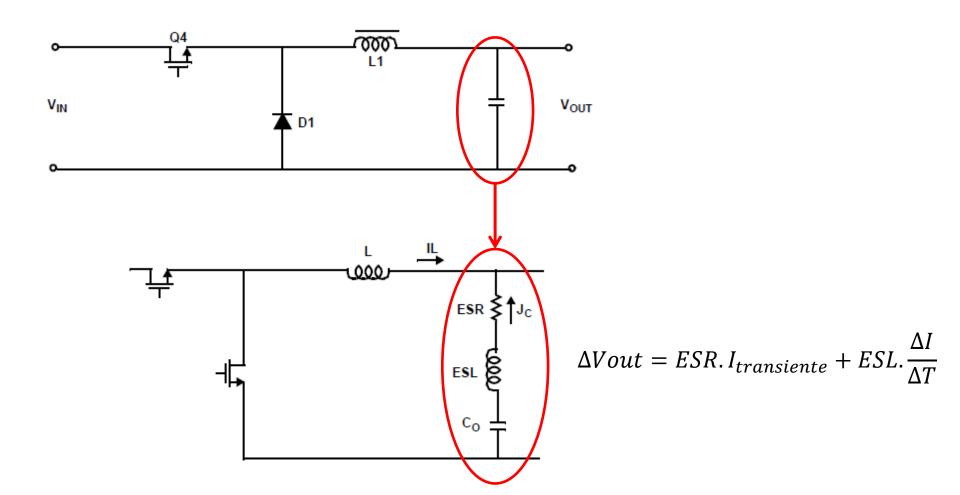
Capacitance vs. Frequency



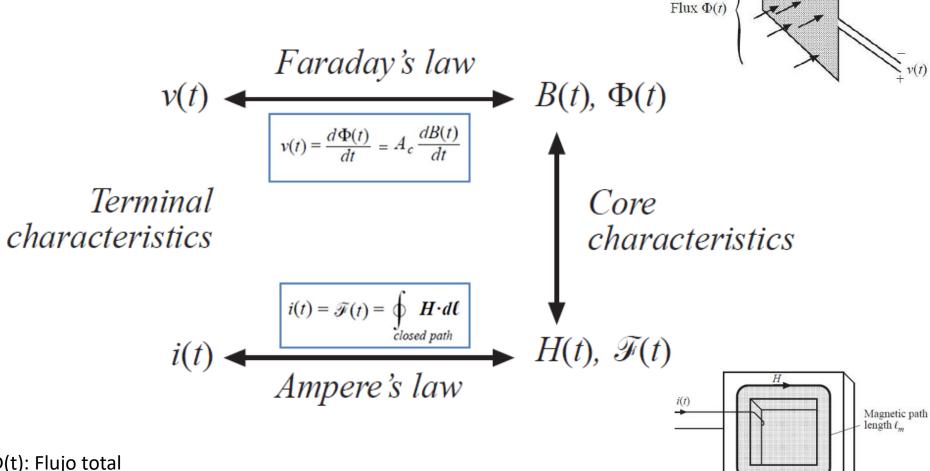
Capacitores: Ejemplo de características

 requency (nz)										
Rated Voltage VDC at 105°C	Rated Capacitance	Case Code/ Case Size	KEMET Part Number	DC Leakage	DF	ESR	Maximum Allowable Ripple Current	MSL	Maximum Operating Temperature	
Not all parts are 105°C rated	μF	KEMET/EIA	(See below for part options)	µA at 25°C Maximum/ 5 Minutes	% at 25°C 120 Hz Maximum	mΩ at 25°C 100 kHz Maximum	(rms) mA at +45°C 100 kHz	Reflow Temp ≤ 260°C	°C	
2	470	V/7343-19	T520V477M002A(1)E040	94	10	40	2,200	3	105	
2.5	47	A/3216-18	T520A476M2R5A(1)E090 ^	11.75	8*	90	1,100	3	105	
2.5	68	A/3216-18	T520A686M2R5A(1)E070 ^	17	8*	70	1,300	3	105	
2.5	68	A/3216-18	T520A686M2R5A(1)E080 ^	17	8*	80	1,200	3	105	
2.5	100	T/3528-12	T520T107M2R5A(1)E040	25	8	40	1,600	3	105	
2.5	100	T/3528-12	T520T107M2R5A(1)E070	25	8	70	1,200	3	105	
2.5	100	T/3528-12	T525T107M2R5A(1)E080	25	10	80	1,100	3	125	
2.5	100	B/3528-21	T520B107M2R5A(1)E025	25	8	25	2,300	3	105	
2.5	100	B/3528-21	T520B107M2R5A(1)E035	25	8	35	1,900	3	105	
2.5	100	B/3528-21	T520B107M2R5A(1)E040	25	8	40	1,800	3	105	
2.5	100	B/3528-21	T520B107M2R5A(1)E070	25	8	70	1,300	3	105	
2.5	150	U/6032-15	T520U157M2R5A(1)E055	37.5	8	55	1,600	3	105	
2.5	220	A/3216-18	T520A227M2R5A(1)E025 ^	55	8*	25	1,732	3	105	
2.5	220	A/3216-18	T520A227M2R5A(1)E035 ^	55	8*	35	1,500	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E015	55	8	15	2,900	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E018	55	8	18	2,700	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E021	55	8	21	2,500	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E025	55	8	25	2,300	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E030	55	8	30	2,100	3	105	
2.5	220	B/3528-21	T520B227M2R5A(1)E035	55	8	35	1,900	3	105	

Capacitores: Ejemplo



Componentes magnéticos



Area A

Φ(t): Flujo total

B(t): Densidad de flujo

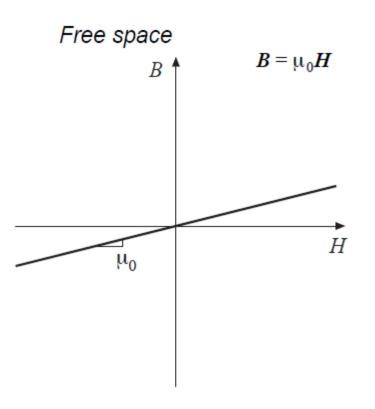
 $\Phi(t) = B(t)A_c$ si $\Phi(t)$ esta uniformemente distribuido atravesando el área A_c

F(t): Fuerza magneto motriz

H(t): Intensidad de campo magnético

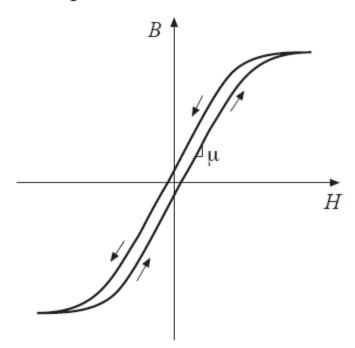
 $F(t) = H(t)L_m$ si H(t) esta uniformemente distribuido a lo largo del camino magnético L_m

Componentes magnéticos: Característica B-H



 μ_0 = permeability of free space = $4\pi \cdot 10^{-7}$ Henries per meter

A magnetic core material



Highly nonlinear, with hysteresis and saturation

Componentes magnéticos: Característica Inductor

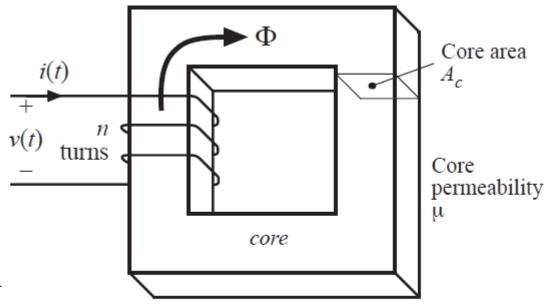
Ley de Faraday:

Para cada vuelta de alambre, podemos escribir

$$v_{turn}(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

El voltaje total del bobinado es

$$v(t) = nv_{turn}(t) = n \frac{d\Phi(t)}{dt}$$



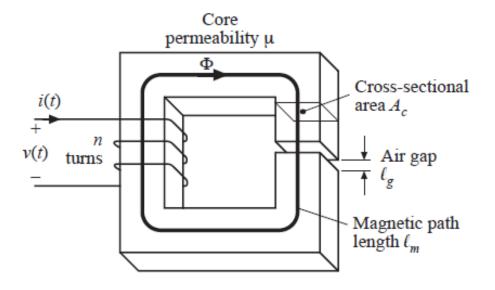
Reemplazando el flujo total por la inducción $B(t) = \Phi(t)/A_c$

$$v(t) = nA_c \frac{dB(t)}{dt}$$

De la Ley de Ampere, tenemos

$$H(t) \ell_m = n i(t)$$

Componentes magnéticos: Característica Inductor con entrehierro

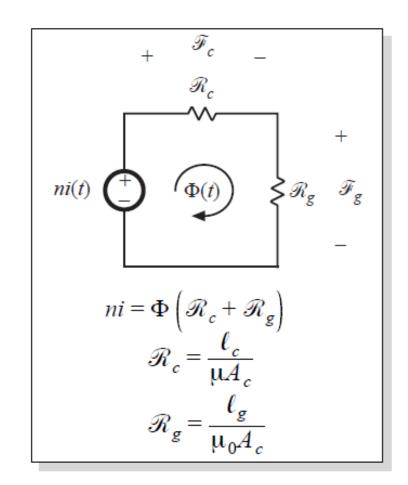


Ley de Faraday: $v(t) = n \frac{d\Phi(t)}{dt}$

Sustituyendo Φ : $v(t) = \frac{n^2}{\Re_c + \Re_g} \frac{di(t)}{dt}$

Por lo que la inductancia es:

$$L = \frac{n^2}{\mathcal{R}_c + \mathcal{R}_g}$$





- Disminuye la inductancia.
- · Aumentá la corriente de saturación.
- entrehierro La inductancia es menos dependiente de la permeabilidad del núcleo.

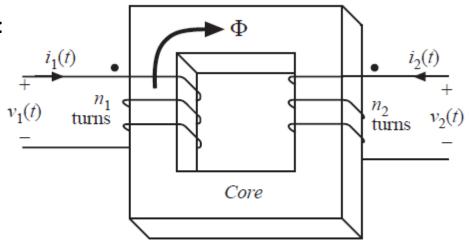
Componentes magnéticos: Característica Transformador

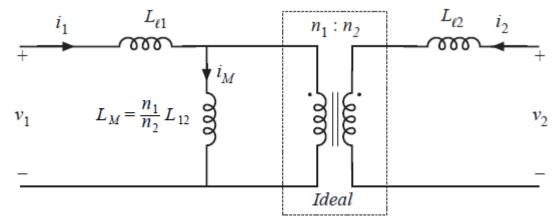
Dos devanados, sin entrehierro:

$$\mathcal{R} = \frac{\ell_m}{\mu A_c}$$

$$\mathcal{F}_c = n_1 i_1 + n_2 i_2$$

$$\Phi \mathcal{R} = n_1 i_1 + n_2 i_2$$





Relación de vueltas efectiva $n_e = \sqrt{\frac{L_{22}}{L_{11}}}$

Coeficiente de acoplamiento $k = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$

Inductancia mutua:

$$L_{12} = \frac{n_1 n_2}{\Re} = \frac{n_2}{n_1} L_M$$

Inductancias propias del primario y secundario:

$$L_{11} = L_{\ell 1} + \frac{n_1}{n_2} L_{12}$$

$$L_{22} = L_{\ell 2} + \frac{n_2}{n_1} L_{12}$$

Componentes magnéticos: Pérdidas

Pérdidas del cobre

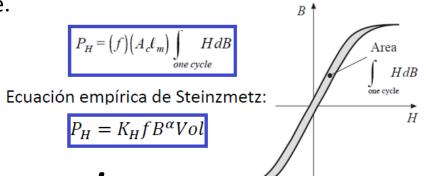
Efecto pelicular (skin effect) en altas frecuencias

La resistividad del cobre aumenta con la frecuencia y se calcula la profundidad de penetración para una frecuencia dada con el fin de obtener el aprovechamiento de la sección del conductor.

$$\delta = \frac{7.5}{\sqrt{f}}[cm]$$
, para el cobre a temperatura ambiente.

Pérdidas por histéresis

Las pérdidas por histéresis son proporcionales a la frecuencia aplicada.



Corrientes de Eddy en altas frecuencias

Si se supone que la impedancia del núcleo es puramente resistiva, entonces las corrientes de Eddy son proporcionales al voltaje inducido, por lo que la magnitud de las corrientes inducidas son proporcionales a la frecuencia f.

Ecuación empírica de Steinzmetz: $P_H = K_E f^2 B^2 Vol$

$$P_H = K_E f^2 B^2 Vol$$

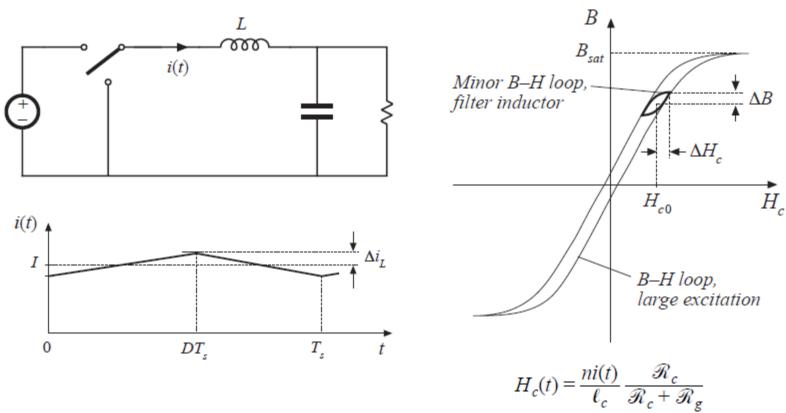
Efecto de proximidad en altas frecuencias

Ecuación empírica, a una frecuencia fija: $P_{fe} = K_{fe} (\Delta B)^{\beta} A_c \ell_m$

$$P_{fe} = K_{fe} (\Delta B)^{\beta} A_c \ell_m$$

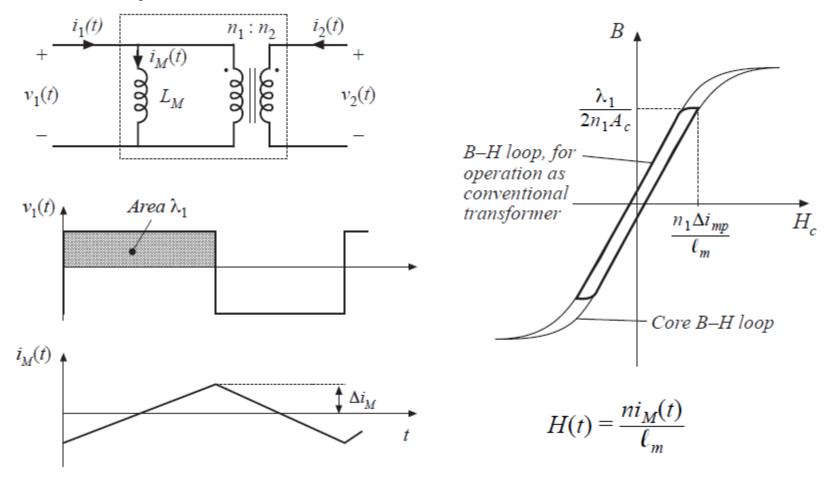
Componentes magnéticos: Aplicaciones, inductor de filtrado.

Ejemplo Buck en MC



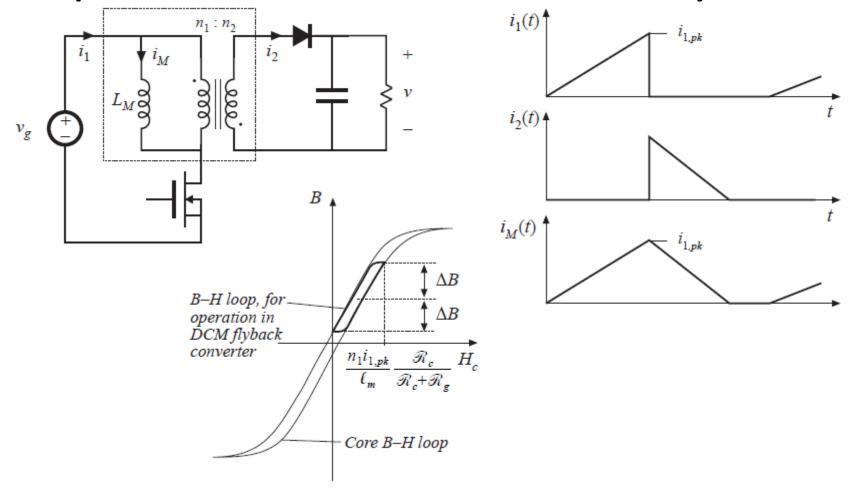
- Pérdidas del núcleo y de proximidad despreciables
- Dominan las pérdidas del cobre
- Elegir flujo magnético para evitar saturación

Componentes magnéticos: Aplicaciones, transformador.



- Pérdidas del núcleo, de proximidad y del cobre apreciables.
- No se usa entrehierro.
- La densidad de flujo se elige para reducir pérdidas del núcleo.
- Se debe elegir un férrite que opere en alta frecuencia.

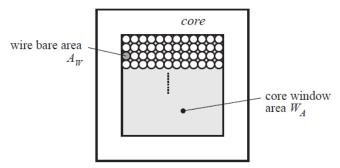
Componentes magnéticos: Aplicaciones, transformador flyback.



- Pérdidas del núcleo, de proximidad y del cobre apreciables.
- Se usa entrehierro.
- La densidad de flujo se elige para reducir pérdidas del núcleo.
- Se debe elegir un férrite que opere en alta frecuencia.

Inductor de filtrado: Restricciones

•
$$nI_{max}=B_{max}AcR_g=B_{max}rac{l_g}{\mu_0}$$
 wire bare area wire bare a_{M_w}



$$L = \frac{n^2}{R_g} = \frac{\mu_0 A_c n^2}{l_g}$$

- $K_u W_A \ge n A_w$, Ku: Factor de utilización de la venta; W_A : Área de ventana; A_w : Sección del conductor.
- $R=
 ho rac{n(MLT)}{A_W}$, MLT: Largo promedio por vuelta

 $n, l_g \ y \ W_A$ son las incógnitas. Usando las cuatro restricciones se puede llegar a la siguiente relación.

$$K_g = \frac{{A_c}^2 W_A}{(MLT)} \ge \frac{\rho L^2 I_{max}^2}{B_{max}^2 R K_u}$$

Bibliografía

- C. A. Harper, "Passive Electronic Component Handbook", Mc. GrawHill, 1997.
- Richard C. Dorf, "The Electrical Engineering Handbook", CRC Press & IEEE Press, 1997.
- Hank Zumbahlen, "Basic linear design", Analog Devices, 2007.
- Vishay Application Note, "Basics of Linear Fixed Resistors", 2008.
- Ohmite Application Note, "Resistor Selection".
- Kemet Application Note, "Introduction to Capacitor Technologies", 2013.
- R. W. Erickson, "Fundamental of Power Electronics", Springer Science & Business Media, 2001.
- Alex Van den Bossche, Vencislav Cekov Valchev, "Inductors and Transformers for Power Electronics", 2005.
- W. G. Hurley, W. H. Wolfle, "Transformers and Inductors for Power Electronics", Wiley, 2013.
- H. E. Tacca, "Flyback vs. Forward converter topology comparison based upon magnetic design"